

Some possibilities of the use of confluence analysis for an interval parameter estimation of semiconductors in a cathodoluminescent microscope

Yu. E. Gagarin, M. A. Stepovich

Kaluga Branch of Bauman Moscow State Technical University, Kaluga, Russia

The methods of mathematical modeling have been applied to study possibilities of using confluence analysis for interval estimation of diffusion lengths of minority charge carriers in semiconductors. Confluence analysis has been realized for directly zoned semiconductors at different measurands errors of electron beam energies characteristic of real experiment.

Л и т е р а т у р а

1. *Петров В. И., Степанов С. Е., Степович М. А.*//Изв. РАН. Сер. физ. 1999. Т. 63. № 7. С. 1332.
2. *Грешилов А. А.* Анализ и синтез стохастических систем. Параметрические модели и конфлюентный анализ. — М.: Радио и связь, 1990.
3. *Михеев Н. Н., Петров В. И., Степович М. А.*//Изв. РАН. Сер. физ. 1992. Т. 56. № 3. С. 176.
4. *Гагарин Ю. Е., Петров В. И., Степович М. А.*//Там же. 2001. Т. 65. № 9. С. 1308.
5. *Гетманская И. В., Степович М. А.*//Сб. тр. международной науч.-техн. конф. "Приборостроение-2002". Винница-Алупка. Винницкое представительство ВМУРоЛ "Украина", 2002. С. 209.